Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11-101992(43)Date of publication of application: 13.04.1999

(51)Int.CI.

G02F 1/136

G02F 1/1333

G02F 1/1335

G02F 1/1343

G09F 9/35

(21)Application number: 10-195219 (71)Applicant: SHARP CORP (22)Date of filing: 10.07.1998 (72)Inventor: KUBO MASUMI

NARUTAKI YOZO FUJIOKA SHIYOUGO

(30)Priority

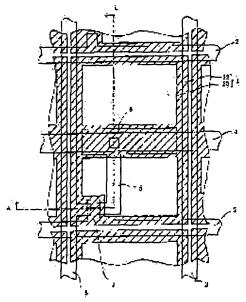
Priority number: 09201176 Priority date: 28.07.1997 Priority country: JP

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the luminance of a liquid crystal display device by providing the device with pixel electrodes in such a manner that gate wiring and source wiring partly overlap on each other via interlayer insulating films and constituting the pixel electrodes of transparent regions and reflection regions.

SOLUTION: The gate wiring 2 and the source wiring 3 partly overlap on each other via the outer peripheral parts of the pixel electrodes 1 and the interlayer insulating films 19. The pixel electrodes 1 consist of the reflection regions 22 consisting of metallic films and the transmission regions 20 consisting of ITO. The reflection regions 22 are formed on the gate wiring 2, the source wiring 3, thin-film transistors(TFTs) 4 and auxiliary capacitor electrodes 8 and are so formed as to be enclosed with the transmission regions 22. The execution of the display with the light transmitted through the transmission regions 20 is made possible by using a back light when the ambient light is dark and the execution of the display by the light reflected by the reflection regions 22 is made possible



when the ambient light is bright by using such liquid crystal display panel. The bright display device is obtd. by executing the display with both of the transmission regions 20 and the reflection regions 22.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2955277

[Date of registration]

16.07.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(18)日本国特許庁(JP)

(12)特 許 公 報(B2)

(11)特許滑号

第2955277号

(45)発行日 平成11年(1999)10月4日

(24)登録日 平成11年(1999)7月16日

(51) IntCL ^o		識別記号	F I		
G02F	1/136	500	GO2F	/136	500
	1/1333	505	1	/1333	505
	1/1335	5 2 0	1	1/1335	620
	1/1343		1	1/1343	
GOSF	9/35	320	G09F	35	320
					前求項の数7 (全 11 頁)
(21)出展番号		特觀平 10-195219	(73)特許權者	000005	049
				シャー	プ株式会社
(22)出版日		平成10年(1998) 7月10日		大阪府	大阪市阿什斯区县池町22番22号
			(72) 発明者	久保	真養
(65)公開番号		特期平11-101992		大阪府大阪市阿伯野区长袖町22番22号	
(43)公開日		平成11年(1999)4月13日		*+-	プ株式会社内
客查前求日		平成11年(1999)4月18日	(72) 発明者	香港	
(31)優先權主義番号		传鞭平9-201176	1	大阪府	大阪市阿伯罗区長地町22番22号
(32) 優先日		平9 (1997) 7月28日		シャー	プ株式会社内
(33) 優先權主張固		日本 (J P)	(72)発明者	斯 岡	正悟
				大阪府	大數市阿倍斯区長她町22番22号
			l	シャー	プ株式会社内
			(74)代理人	弁理士	小池 医胃
			籍或官	井口	酒二
			(56)参考文章	1 特別	平7-318929 (JP, A)
					最終質に使く

(54) 【発明の名称】 被基表示装置

1

(57) 【特許諸求の顧用】

【請求項1】 複数のゲート配線と、該ゲート配線と直 交するように配置された複数のソース配線と、前記ゲー ト配線と前記ソース配線の交差部付近に設けられたスイ ッチング素子と、該スイッチング素子に接続された面素 電極とを備えたアクティブマトリクス基板を備えた液晶 表示装置において、

前記画素電極は、前記ゲート配線と前記ソース配線に囲 まれた領域に層間絶縁膜を介して前記ゲート配線及び前 記ソース配線と一部が重なるように設けられると共に、 10 【請求項5】 前記画素電板の反射領域に設けられた金 前記画器電極は、透過領域と、前記ゲート配線、前記ソ 一ス配線又は前配スイッチング素子上に形成される反射 領域とから成ることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記画素電極との間に絶縁膜を介して補 助容量を形成する補助容量電極を設け、該補助容量電極

上に前記画素電極の反射領域を設けることを特徴とする 請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記四素電極の反射領域に設けられた金 展膜の下に透明導電膜を設けることを特徴とする語求項 1万至諸求項2に記載の被品表示装置。

【請求項4】 前記函素電極の反射領域に設けられた金 展膜の下に前配層間絶縁膜を設け、前記層間絶縁膜の表 面に凹凸を設けることを特徴とする請求項1万至請求項 3に記載の液晶表示装置。

屈膜の膜厚を前記画素電極の透過傾域に設けられた透明 **導電膜の膜厚より厚くすることを特徴とする請求項1万** 至譜求項4に記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記反射領域の液晶の厚みを前記透過領 域の被晶層の厚みより小さくすることを特徴とする請求

いつ・リエエン

(2)

3

項1乃至請求項4に記載の被品表示装置。

【請求項7】 前記回紫電極の反射領域における被品の 原みを前記画索電極の透過領域における液晶の厚みの1 /2とすることを特徴とする請求項1万季請求項5に記 載の被品表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透過表示領域と反射表示領域を備えた液晶表示装置に関するものである。 【0002】

【従来の技術】液晶表示装置は、急型で低消費電力であるという特徴を生かして、ワードプロセッサやバーソナルコンピュータなどのOA機器や、電子手候等の携帯情報機器、あるいは、液晶モニターを備えたカメラー体型 VTR等に広く用いられている。

【0003】被品パネルはCRT (プラウン管) やEL (エレクトロルミネッセンス) 表示装置とは異なり自ら発光しないため、バックライトと呼ばれる蛍光管を備えた装置を背後に設置して、バックライトからの光の透過と遊断を被晶パネルで切り替えて表示を行う透過型液晶 20表示装置が用いられている。

【0004】しかし、透過型液晶表示装置では、通常パックライトが液晶表示装置の全消費電力のうち50%以上を占めるため、バックライトを設けることで消費電力が多くなってしまう。

【0005】よって、戸外や常時携帯して使用する機会が多い携帯情報機器ではバックライトの代わりに反射板を設置し、反射板による周囲光の反射光の透過と遮断を被晶パネルで切り替えて表示を行う反射型液晶表示装置も用いられている。

【0006】反射型液晶表示装置で用いられる表示モードには、現在透過型で広く用いられているTN(ツイステッドネマティック)モード、STN(スーパーツイステッドネマティック)モードといった偏光板を利用するものや、偏光板を用いないため明るい表示が実現できる特別平4-75022号公報や、特別平9-133930号公報に示された相応移型ゲストホストモードも近年盛んに開発が行われている。

【0007】しかしながら、周囲光の反射光を利用する 反射型液晶表示装置は、周囲の光が暗い場合には視認性 が極端に低下するという欠点を有する。一方、透過型液 晶表示装置は、反射型液晶表示装置とは逆に周囲光が非常に明るい場合には、周囲光に比べて表示光が暗く見え たり、バックライトによる液晶表示装置の消費電力の増 大等の間題があった。

【0008】 従って上記問題点を解消するために従来では特別平7-333598号公報に示されるように、光の一部を透過し、また光の一部を反射する半透過反射膜を用いることにより、透過型表示と反射型表示の両方の表示を1つの液晶パネルで実現する構成が示されてい

వ.

【0009】図8に半透過反射膜を用いた液晶表示装置を示す。液晶表示装置は、偏光板30、位相差板31、透明基板32、ブラックマスク33、対向電極34、配向膜35、液弧層36、MIM37、阻素電極38、光 339、反射膜40から構成されている。

【0010】半透過反射膜である画素電極38は、金属粒子を轉く堆積させて形成しており、光源39からの光を画素電極38から透過させると共に、自然光や室内照10 明光等の外光を画素電極38で反射させることによって透過型表示機能と反射型表示機能とを実現することができる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図8に示された表示装置では半透過反射膜である両素電極38は、光を透過してしまうため、MIM37等のスイッチング素子に画案電極38を通して光が入り込み、スイッチング特性が変化するためブラックマスク33によって避光する必要がある。

【0012】また、MIM37を用いた構成では晒素電極38と対向電極34の重なる領域が表示領域となるため隣接する対向電極間は光の遮蔽や透過の切り替えができないため、光抜けを防止するためにブラックマスク33を設ける必要があり、ブラックマスク33に囲まれた領域が表示領域となるため、表示領域を増やすことができない。

【0013】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、透過型表示と反射型表示を一枚の基板で実現する液晶表示装置において、従来の液晶表示装置 80 においてブラックマスクを用いて遊光していた領域を表示領域として利用することができる液品表示装置を提供することを目的とする。

[0014]

【歌題を解決するための手段】本発明は、複数のゲート 配線と、波ゲート配線と直交するように配置された複数 のソース配線と、前記ゲート配線と前記ソース配線の交 差部付近に設けられたスイッチング素子と、該スイッチ ング素子に接続された画素電極とを備えたアクティブマ トリクス基板を備えた液晶表示装置において、前記画素 電極は、前記ゲート配線と前記ソース配線に囲まれた領 域に絶縁膜を介して前配ゲート配線及び前記ソース配線 と一部が異なるように設けられると共に、前沿画素電極 は、透過領域と、前記ゲート形線、前記ソース配線又は 前配スイッチング素子上に形成される反射領域とから成 ることを特徴とする。これにより、透過型表示と反射型 表示を一枚の基板で実現する液晶表示装置において、従 来の液晶表示装置でブラックマスクを用いて遊光してい た領域を画素電極の反射領域として用いるため、液晶バ ネルの両素電極の表示領域を有効に利用することができ るので液晶表示装置の輝度を高めることができる。

5

【0015】また、本発明は、前記國素電極との間に絶 縁膜を介して補助容量を形成する補助容量電極を設け、 該補助容量電極上に前記國素電極の反射領域を設けるこ とを特徴とする特徴とする。これにより、補助容量電極 によりバックライト光が遮光される領域を画素電極の反 射領域として表示に利用することができる。

【0016】また、本発明は、前記画素電極の反射領域に設けられた金属膜の下に透明導電膜を設けることを特徴とする。これにより、表面に凹凸が存在する透明導電膜上に金属膜を形成することにより、表面に凹凸が設け 10られた画素電極の反射領域が得られ、様々な入射角度の周囲光を表示光として利用することができる。

【0017】また、本発明は、前記國宗田極の反射領域に設けられた金属膜の下に前配居間絶縁膜を設け、前配層関絶縁膜の表面に凹凸を設けることを特徴とする。これにより、表面に凹凸が設けられた層間絶縁膜上に金属膜を形成することにより表面に凹凸が存在する画素電極の反射領域が得られ、様々な入射角度の周囲光を表示光として利用することができる。

【0018】また、本発明は、前記画素電極の反射領域 20 に設けられた金属膜の膜原を前記画素電極の透過領域に設けられた透明導電膜の膜原より原くすることを特徴とする。また、前記反射領域の液晶の厚みを前記透過領域の液晶層の厚みより小さくすることを特徴とする。これにより、画素電極の反射領域において液晶を往復して通過する周囲光の液晶層での光路長と、画素電極の透過領域において液晶を透過する光の液晶層での光路長を近づけることができ、画素電極の反射領域と透過領域での液晶層での光の特性の変化を揃えることができる。

【0019】また、本発明は、前記画素電極の反射傾域 30 の被晶のセルギャップを前記画素電極の透過領域の液晶 のセルギャップの1/2とすることを特徴とする。これにより、画素電極の反射領域において液晶を往復して通過する周囲光の液品層での光路長と、画素電極の透過領域において液晶を透過する光の液品層での光路長を近づけることができ、画素電極の反射領域と透過領域での液晶層での光の特性の変化を一致させることができる。

[0020]

【発明の実施の形態】

(実施形態1) 図1に、本発明の実施形態1である被品表示装置におけるアクティブマトリクス基板の阿索部分の平面図を、図2に、図1のαーb部の断面図を示す。

【0022】ゲート配線2とソース配線3は、その一部 が画素電極1の外周部分と層間絶縁膜19を介して重な っている。ゲート配線2及びソース配線3は金属膜で形 50

成されている。

【0023】また、ゲート配線2とソース配線3の交景 部付近に、西衆電極1に表示信号を供給するためのスイ ッチング索子としての精膜トランジスタ4(以下TFT という)が設けられている。

6

【0024】このTFT4のゲート電極12にはゲート配線2が接続され、ゲート電極12に入力される信号によってTFT4が駆動が御される。またTFT4のソース電極15にはソース配線3が接続され、ソース電極15にデータ信号が入力される。更にTFT4のドレイン電極16には接続電極5が接続され、更にコンタクトホール6を介して画業電極1と電気的に接続される。

【0025】接続電極5は、ゲート絶縁膜7を介して、補助容量電極8との間に補助容量を形成している。補助容量電極8は、金属膜で形成され、図示しない配線によって対向基板9に形成された対向電極10に接続されている。また、補助容量電極8はゲート配線2と同一工程で形成されてもよい。

【0026】 國素電極1は、金属際からなる反射領域2 2と、ITOからなる透過領域20からなり、反射領域 22は、ゲート配線2、ソース配線3、TFT4及び補助容量電極8の上に形成され、透過領域20は反射領域 22に囲まれるように形成されている。

【0027】以上のように本実施形態1のアクティブマトリクス基板が構成され、以下のようにして製造することができる。

【0028】まず、ガラス等の透明的解性基板11上に ゲート価極12、ゲート配線2、補助容量価極8、ゲート約線膜7、半導体層13、チャネル保護層14、ソース電極15及びドレイン電極16を順次成膜して形成する。次にソース配線3及び接続電極5を構成する週明等電膜17と金属膜18をスパッタ法により積層形成して所定形状にパターニングする。

【0029】ソース配線3はITOからなる透明等電膜17と金属膜18との2層構造としており、金属膜18の一部に断線等の欠損があったとしても透明将電膜17によって電気的に接続されるためソース配線3の断線を少なくすることができる。

【0030】更にその上に層間総縁膜19として感光性のアクリル樹脂をスピン塗布法により3µmの膜厚で形成する。アクリル樹脂に対して、所望のバターンに従って露光し、アルカリ性の溶液によって現像処理する。これにより露光された部分のみがアルカリ性の溶液によってエッチングされ、層間絶縁膜19を負通するコンタクトホール6を形成する。このアルカリ現像によるコンタクトホール6の形成においては、コンタクトホール6のデーバ形状も良好なものであった。

【0031】この様に層間絶縁膜19として感光性のア クリル樹脂を用いることより、薄膜の形成をスピン塗布 法によって形成することができるので数μmという膜厚

7

の薄膜を容易に形成することができ、層間絶縁膜19の パターニングにはフォトレジストの塗布工程が不要となる等、生産性の点で有利である。

【0032】また、本実施例において用いたアクリル樹脂は着色されており、パターニング後に全面に露光処理を施すことによって透明化することができる。上記透明化処理は化学的にも行うことが可能であり、それを用いても良いことは言うまでもない。

【0033】その後、断素電極1の透過領域20となる 透明導電膜21をスパッタ法により形成しパターニング 10 する。透明導電膜21の材料としてはITOを用いてい る。

【0034】これにより画索電極1の透過領域20となる透明等電膜21は、層階絶縁膜19を貫くコンタクトホール6を介して接続電極5と電気的に接続される。

【0035】次にゲート面線2、ソース面線3、TFT 4及び補以容量電極8と重なるように透明等電膜21の上に面素電極1の反射領域22となる金属膜23を形成しており、透明等電膜21と金属膜23は電気的に接続されている。機接する面素電極1の間は電気的に接続さ 20 れないにようにゲート面線2及びソース配線3上で離間されている。金属膜23の材料としてはA1を用いているが、Ta等を用いてもよく、反射率が高く導電性をもつ膜であればよい。

【0036】 このようにして本実施形態1のアクティブマトリクス基板を製造することができる。

【0037】本実施形態1では図2に示すように分子の配向方向によって光の吸収係数が異なる色素である2色性色素24を溶解として被晶中に溶解させ、液晶分子25の配向状態を、対向電極10と画素電極1との間の電 30外を制御することによって、2色性色素24の分子配向方向を同時に変化させ2色性色素24の配向方向による光の吸収係数の変化を用いて表示を行う。

【0038】本実施形態1の被晶表示パネルを用いることにより、周囲光が暗い場合はパックライトを用い透過 領域20を透過した光で表示を行ない、周囲光が明るい場合は、反射領域22で反射した光で表示を行なうことができ、また透過領域20と反射領域22の両方で表示を行い明るい表示接近を実現することができる。

【0039】更に、本実施形態1の液晶表示装置では、 TFT4、ゲート配線2及びソース電極3上に國素電極 1の反射領域22である金属膜23を設けており、TF T4への光の入射を防止し、ドメインやディスクリネー ションライン等の表示領域内の光漏れが発生しやすいゲート配線、ソース配線及び補助容量電極上の画素電極を 遮光するための遮光膜を設ける必要がなく、従来必要で あった遮光膜によって表示傾域として用いることができ なかった傾域を画素電極の表示領域として用いることが できるため、液晶パネルの表示領域を有効に使用することができる。 【0040】また、ゲート面線やソース色極が金属膜で形成されている場合、透過型表示装置では、遮光節域と

なるため表示領域としては用いることができなかった
が、本実施形態の液晶表示装置は、従来透過型表示装置
では遮光領域として用いられていた領域を画索電極の反射領域として用いることができるため、明るい表示を得ることができる。

【0041】また、実施形態1の被晶表示装置では、透明導電膜21の上に金属膜23を設けているため、透明等電膜21の表面に存在する凹凸によって、表面に凹凸が形成された金属膜23を得ることができる。金属膜23の表面は平坦であるより凹凸が形成されている方がさまざまな入射角度の周囲光を利用することが可能であり、より明るい液晶表示装置を実現することができる。

【0042】また、他の例として、図3又は図4の平面図に示すように、函素電極1における透過領域20と反射領域22の面積の比率を変えることにより、希望する反射率、透過率を有する液晶表示装置が得られる。

【0043】更に、図3又は図4に示すように接続電極 5を反射似域22に設けることにより、透過領域20で の透過光の輝度の低下を抑えることができる。

【0045】(実施形態2)金属膜23の凹凸を形成する他の例を示す。

【0046】図5は実施形態1の層間絶縁膜19と金属膜23の部分構成を表す平面図であり、図6はそのcー 動面図を示している。

【0047】層間絶縁膜19の表面にエッチング等で凹凸を形成し、その上に金属膜23を形成している。

【0048】スピン塗布法等により平坦に形成される層間絶縁膜19の上に金属膜23を形成する場合でも層間絶縁膜19の表面に凹凸を形成することにより、表面に凹凸を設けた金属膜23を得ることができる。反射型液晶表示装置では、金属膜23の表面が平坦であるより、凹凸が存在する方がさまざまな入射角度の周囲光を利用することが可能であり、図に示すように画素電極1の金属膜23を、エッチング等で凹凸を形成した層間絶縁膜19の上に形成することで、より明るい反射型液晶表示装置を実現することができる。

【0049】金属膜23の表面の凹凸形状は図5、図6で示した円形状に限定されるものではない。従って、その下層の層間絶偏膜19の最面の凹凸の平面形状は多角形や楕円等でもよく、また断面形状も図に示す半円形状でなくても多角形状でもよい。

【0050】(実施形態3)次に、ゲストホスト方式で 50 表示を行う被侃表示装置の実施形態について説明する。

NV. 141)

特許第2955277号

【0051】ここで図7は被晶本示装置の断面構成であ り実施形態1と同じ構成は同じ符号を付している。

【0052】被晶に黒色色素を混入したゲストホスト液 晶ZLI2327(メルク社製)に、光学活性物質Sー 811 (メルク社製) を0. 5%混入したものを使用す るゲストホスト方式で表示を行なう場合、バックライト 光を用いる透過領域の透過光の光路長dfと、周囲光を 用いる場合の反射領域の反射光の光路長2drが著しく 異なると、液晶層に閉じ電圧を印加してもバックライト 光を用いる場合と周囲光を用いる場合で、明るさやコン 10 トラストが著しく異なる。よって、透過領域の透明導電 膜21上の液晶層のギャップdfと反射領域の金属膜2 3上の被晶層のギャップdrとの関係は、df=2dr を潰たすように形成する必要があり、本実施形態3で は、金属膜23の膜厚を変えるパー2drを満たすよう に形成している。

【0053】図7に示すように、パックライト光を用い る場合の透過領域の透過光の光路長dfと周囲光を用い る場合の反射領域の反射光の光路長2 d r を一致させる ことで、被晶層に同じ電圧を印加した時、バックライト 20 光を用いる場合と周囲光を用いる場合で、明るさやコン トラストを揃えることが可能になり、より以好な表示特 性の液晶表示装置が得られる。

【0054】ここで、必ずしもバックライト光を用いる 場合の透過領域の透過光の光路長dfと周囲光を用いる 場合の反射領域の反射光の光路長2 drを一致させなく ても、近い値にすることで明るさやコントラストをある 程度揃えることができる。

【0055】またバックライト光を用いる場合の透過質 域の透過光の光路長dfと周囲光を用いる場合の反射領 30 による反射光において約25が得られた。 域の反射光の光路長2 d r が著しく異なっていても、バ ックライト光を用いる場合と周囲光を用いる場合で、液 晶の印加電圧を変えるような駆動を用いても、コントラ ストを描えることが可能になる。

【0056】 図9に反射電極の構成の異なる被晶表示装 置を示す。この液晶表示装置は、反射電極を凹凸である ため、drは反射領域の光路長の平均値となる。

【0057】図10に電極間造の民なる被晶表示装置を 示す。この液晶表示装置は、反射領域において、液晶層 に電圧を印加する電極は透明電極となるが、反射領域の 40 透明電極の下には透明な絶縁層を介して反射電極が形成 されている。反射電板上に形成された絶縁層によって、 反射領域と透過領域の液晶層の厚みが異なっている。

[0058] dr<dfとすると、画素電極の反射領域 において被晶を往後して通過する周囲光の液晶層での光 路長と國素電極の遷過領域において被品を通過する光の 液晶層での光路長を近づけることができ画索電極の反射 領域と透過領域での液晶層での光の特性の変化を揃える ことができる。

【0059】実施形態としてゲストホスト型の液晶表示 50

装置を記載しているが、他の表示モードであっても反射 領域と透過領域での光路長の差による表示光の特性が異

10

なる場合、反射領域の液晶層での光路長と透過領域の光 路長を近づけることで光の特性の変化を揃えることがで きる。

【0060】対角8、4インチの透過反射両用型液晶表 示装置を作製し、バックライトからの光による透過光と 外光による反射光との64階調表示の特性評価を行なっ た結果を図11に示す。

【0061】外光による透過光の測定はトプコンのBM -5で、外光による反射光の測定は大塚電子製のLCD -5000を用いて測定を行なった。

【0062】この時、トプコンのBM-5ではバックラ イトを光源とし、大塚電子のLCD-5000では外光 光源として積分球を用い、光の取込み角は液晶表示装置 の基板面に対して垂直になるように測定を行なった。

【0063】 この液晶表示装置は画素に対して透過領域 と反射領域の比率を約4対6にし、透過領域をITO、 反射領域をA1で形成した。また、反射領域のセル厚が 約3 μmであるのに対して、透過領域のセル厚は約5. 5μmに設定した。これは、バックライトからの光によ る透過光の光路長と外光による反射光の光路長をできる だけ合わせるためである。透過領域は図11に示すよう に、バックライトからの光による透過光と外光による反 射光の64階調表示の透過率・反射率はほぼ一致してお り、バックライトからの光による透過光と外光による反 射光との両方を同時に利用して表示する時にも、十分な 表示品化が得られる。この時のコントラスト比は、バッ クライトからの光による透過光において約200、外光

【0064】また、図12に従来の対角8、4インチの 透過型液晶表示接置の色再現性を、図13に本発明の対 角8. 4インチの透過反射両用型液晶表示装置の色再現 性を示す。図12に示す従来の透過型液晶表示装置は外 光のパネル照度が800 (1x)、17000 (1x) と増加するにつれて色再現範囲は著しく低下する。しか しなが6図13において、本発明の透過反射両用型液晶 表示装置の色平現は外光のパネル照度が800(1 x)、17000(1x)と増加しても色育現範囲の低 下はほとんど発生していない。これは、従来の透過型液 晶表示装置は外光の液晶表示装置表面での表面反射や、 遮光用のブラックマスク・バスライン等からの反射光に よりコントラストが低下するためである。 ここで、本発 明の透過反射両用型液晶表示装置は外光を用い反射領域 で表示を行なうので、従来の透過型液晶表示装置で発生 したコントラスト低下はどれだけ外光が強くなっても反 射傾域でのコントラスト比以下にはならない。そのた め、本発明の透過反射両用型液晶表示装置は外光のパネ ル服度がどれだけ増加しても色再現範囲の低下はほとん ど発生しないため、どのような環境下においても視認性 11

(体/ ハドソ人

の高い被晶表示装置が得られた。

【0065】本実施形態のように透過領域と反射領域を 備えた被品表示法置は、使用者の都合で、画面の向きを 変えたり、見やすい環境のところへ移動して、作業する ということができないような商品に搭載すれば特に効果 がある。

【0066】本実施形態の液晶表示パネルをバッテリ駆 動方式のデジタルカメラやビデオカメラのビューファイ ンダー(モニター脳面)として採用したところ、周囲光 がどのような明るさであっても、バックライトの解度を 10 調節することによって、電力消費量も少なくし、かつ、 常に観察しやすい明るさに保つことができた。

【0067】 晴天下の屋外で使用した場合、従来の透過 型ではバックライトの輝度を高くしても表示がかすんで しまい見づらくなる。このような時は、バックライトを 消して反射型表示として、あるいは、バックライトの輝 度を低くして反射型表示を併用することで、画面を観察 すれば、画質も良く、電力消費量も少なくすることがで きる。

【0068】明るい日差しが差し込む室内で使用した場 20 合、被写体の方向によって、反射型表示と透過型表示を 切替えたり、併用して見やすい表示とすることができ る。モニター画面に日差しが当たる場合は、晴天下の屋 外で使用した場合と同様にすれば良い。部屋の薄くらい すみから、被写体を撮影する場合、バックライトを点灯 して透過型を併用すれば良い。

【0069】本実施形態の液晶表示パネルをカーナビゲ ーションなど車載用のモニター画面として採用したとき も、周囲光がどのような明るさであっても、常に観察し やすい表示が可能となる。

【0070】従来の透過型液晶表示装置を使用したカー ナビゲーションは、パソコンなどに使用されるバックラ イトよりも高い輝度のバックライトが使用されている。 その理由は、晴天下や、日差しが当たる場合に対応する ためである。しかし、それでも表示がかすんでしまい見 づらくなっている。その反面、夜間や急にトンネル内を **走行する場合、そのままのバックライトの輝度では、明** るすぎて目がちらつき、悪影響をおよぼしていた。そこ で、本発明の液晶表示パネルを使用した場合、常に、反 射型表示を併用することができるので、バックライトの 40 変化を 致させることができる。 輝度を高く設定しなくても、明るい環境下で良好な表示 が実現される。また、真っ暗な環境下でも、少しの輝度 (約50-100cd/m2) で点灯するだけで、見や すい表示が実現される。

[0071]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、透過型表 示と反射型表示を一枚の基板で実現する被晶表示装置に おいて、従来の液晶表示装置でブラックマスクを用いて 遊光していた領域を画素電極の反射領域として用いるこ とができるため、液晶パネルの画素低極の表示領域を有 50 効に利用することができるので液晶表示装置の輝度を高 めることができる。

12

【0072】また、本発明は、前配阿素電極との間に絶 緑膜を介して補助容量を形成する補助容量電極を設け、 該補助谷量電極上に前記画素電極の反射領域を設けるこ とにより、補助容量電極が形成される領域を画来電極の 反射領域として表示に利用することができる。

【0073】また、本発明は、前配画素電極の反射領域 に設けられた金属膜の下に透明導電膜を設けることによ り、凹凸を有する透明将電膜上に金屈膜を形成すること により、表面に凹凸が存在する画素電極の反射領域が得 られ、様々な入射角度の周囲光を表示光として利用する ことができる。

【0074】また、本発明は、表面に凹凸を設けた層間 絶縁膜上に金属膜を形成することにより表面に凹凸が存 在する画素電極の反射領域が得られ、様々な入射角度の 周囲光を表示光として利用することができる。

【0075】また、本発明は、前記画素電極の反射領域 に設けられた金属膜の膜厚を前配面素電極の透過領域に 設けられた透明導電膜の膜厚より厚くすることにより、 面素電極の反射領域において液晶を往復して通過する周 囲光の液晶層での光路長と、囲素電極の透過領域におい て被品を透過する光の被品層での光路長を近づけること ができ、商素電極の反射領域と透過領域での液晶層での 光の特性の変化を揃えることができる。

【0076】また、前記反射領域の液晶の厚みを前記透 過領域の液晶層の厚みより小さくすることにより、画素 電極の反射領域において液晶を往復して通過する周囲光 の被晶層での光路長と、面素角層の透過領域において液 き、画素電極の反射領域と透過領域での液晶層での光の 特性の変化を揃えることができる。

【0077】また、本発明は、前記画楽電極の反射領域 の液晶のセルギャップを前配画素電極の透過領域の液晶 のセルギャップの1/2とすることにより、画素電極の 反射領域において液晶を往復して通過する周囲光の液晶 層での光路長と、画素電極の透過領域において液晶を透 過する光の液晶層での光路長を近づけることができ、画 素電極の反射領域と透過領域での液品層での光の特性の

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基 板を示す平面図である。

【図2】図1のa-b部の断面構成を示す断面図であ **క**.

【図3】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基 板の他の例を示す平面図である。

【図4】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基 板の他の例を示す平面図である。

【図5】本発明の実施形態2の層間絶縁膜19と金属膜

13

特許第2955277号

14

23の部分構成を示す平面図である。		5	绘納電極
【図6】本発明の実施形態2の層間絶縁膜19と金属膜		6	コンタクトホール
23の部分構成を示す断面図である。		7	ゲート絶縁膜
【図7】本発明の実施形態3の被晶表示装置を示す断面		8	補助容量電極
図である。		8	对向基板
【図8】従来の被品表示基置を示す断面図である。		10	对向电荷
【図9】 本発明の他の被晶裁示装置を示す断面図であ		11	透明絕特性益板
5.		12	ゲート電極
【図10】本発明の他の被品表示装置を示す断面図であ		13	半導体層
ఠ.	10	14	チャネル保護層
【図11】本発明の透過光と反射光の特性評価を示す図		15	ソース低極
である.		16	ドレイン電極
【図12】 従来の被晶表示装置の色再現性を示す図であ		17	透明導電膜
థ.		18	金属膜
【図13】本発明の被品表示装置の色再現性を示す図で		19	層的絶縁膜
వ ర్		20	透過領域
【符号の説明】		21	透明導电膜(画素電枢)
1 阿索帕極		22	反射領域
2 ゲート酸線		23	金属膜(國素電極)
3 ソース面線	20	24	2色性色素
4 TFT		25	被晶分子

[図2]

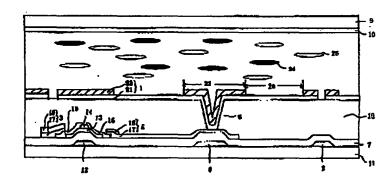
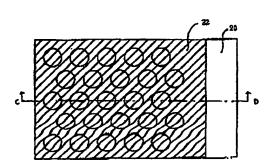


图5]



【図6】

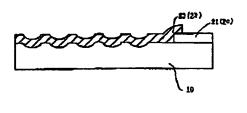
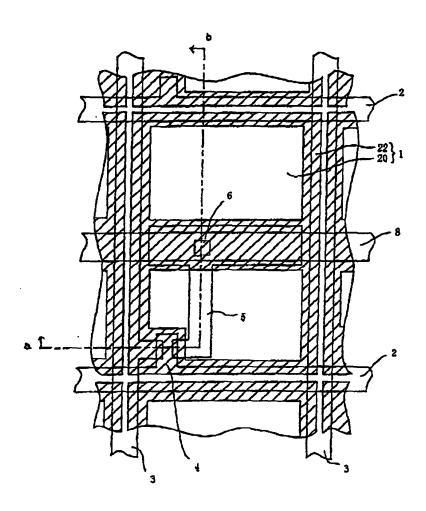
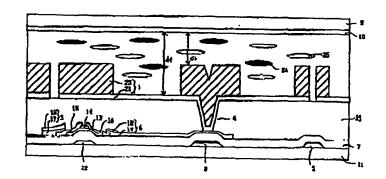


图1]

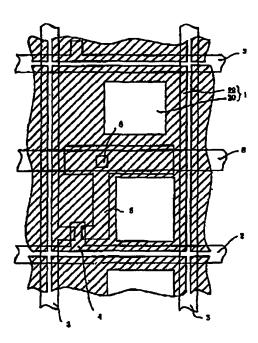


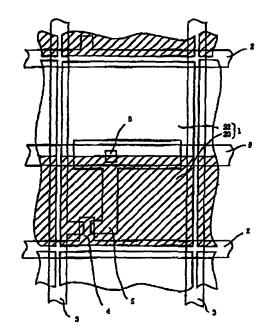
[图7]



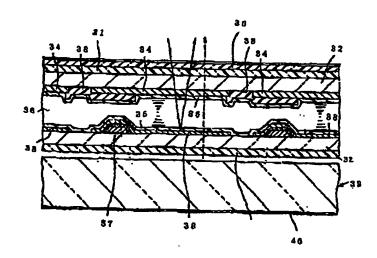
[図3]

[関4]

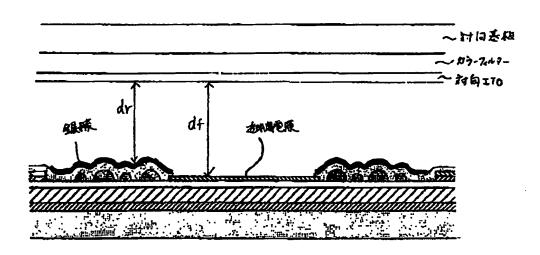




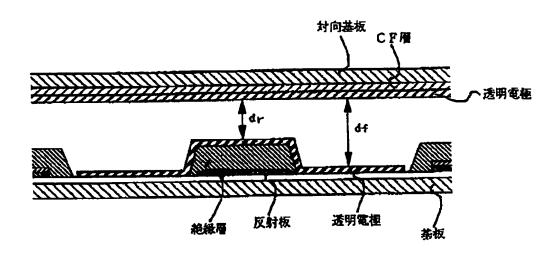
[図8]



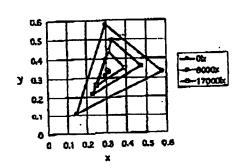
[8]9]



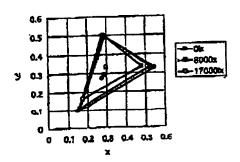
[図10]



[図12]

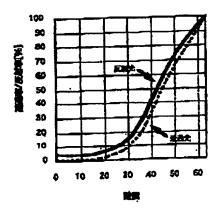


(図13)



(11)

[图11]



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.6, DB名)

G02F 1/136 500

G02F 1/1343